

# 半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 15 卷 第 3 期 1994 年 3 月

## 目 次

- (Pt 及其硅化物)/硅界面的深能级研究 ..... 丁孙安 许振嘉 (149)  
生长在 Si(001) 衬底上的应变合金  $Ge_xSi_{1-x}$  的价带电子能带结构 .....  
..... 徐至中 (156)  
GaAs/Al<sub>0.33</sub>Ga<sub>0.67</sub>As 短周期超晶格中能带不连续性随压力的变化 .....  
..... 刘振先 李国华 韩和相 汪兆平 (163)  
Cd<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te/CdTe 多量子阱的光反射研究 .....  
..... 章灵军 单 伟 姜 山 沈学础 (171)  
适用于宽温度范围和不同沟道掺杂浓度的 MOSFET 反型层载流子迁移率模  
型 ..... 黄骁虎 阮 刚 (180)  
高灵敏度低暗电流 GaAs 量子阱红外探测器 ..... 钟战天 周小川  
杜全钢 周鼎新 吴荣汉 王 森 李承芳 於美云 徐俊英 朱勤生 (188)  
ICB 方法生长 CdTe 单晶薄膜的研究 ..... 冯嘉猷 张芳伟 范玉殿 李恒德 (194)  
多量子阱光波导中非线性 TE 波的有限元解 ..... 赵安平 于荣金 (199)  
**研究快报**  
利用电子束掺杂技术制备微米、亚微米 P-MOSFET 器件 .....  
..... 李秀琼 海潮和 杨 军 (204)  
CdSe/ZnTe 超晶格微观界面模的多声子喇曼光谱研究 .....  
..... 侯永田 金 鹰 张树霖 李 杰 袁诗鑫 (208)  
SiGe/Si 量子阱结构材料的激子发光谱 .....  
..... 黄大鸣 杨 敏 盛 瓯 卢学坤 龚大卫 张翔九 王 迅 (213)  
Determination of Interstitial Oxygen Concentration in Heavily Doped  
Silicon by Combination of Neutron Irradiation and FTIR .....  
..... Ma Zhenyu,  
Wang Qiyuan, Zan Yude, Cai Tianhai, Yu Yuanhuan and Lin Lanying (217)